

ICS 31.080.30

L42

备案号: 7560 — 2000



# 中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11227 — 2000

---

## 电子元器件详细规范 3DA98 型 NPN 硅高频大功率晶体管

**Detail specification for electronic components  
Type 3DA98 NPN silicon high-frequency power transistor**

2000-08-16 发布

2000-10-01 实施

---

中华人民共和国信息产业部 发布

# 前 言

本规范是按照 GB/T 7576—1998《半导体器件 分立器件 第7部分 双极型晶体管 第四篇 高频放大管壳额定双极型晶体管空白详细规范》(idt IEC 747-7-4: 1991)标准对原部标 SJ 1410—78 进行修订的,符合 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(idt IEC 747-10: 1984)和 GB/T 12560—1999《半导体器件 分立器件分规范》(idt EC 747-11: 1996)的 II 类要求。

本规范与前版的主要差别是:

1 增加了前言。

2 电参数测试方法前版引用的是 SJ 300~314—72《半导体三极管测试方法》,本版引用的是 GB/T 4587—1994《半导体分立器件和集成电路 第7部分:双极型晶体管》和 GJB 128A—97《半导体分立器件试验方法》。

3 试验方法前版引用的是 SJ 614—73《半导体三级管总技术条件》,本版引用的是 GB/T 4937—1995《半导体器件机械和气候试验方法》。

本规范由信息产业部电子工业标准化研究所归口。

本规范起草单位:信息产业部电子工业标准化研究所。

本规范主要起草人:赵 英、强桂华。

本规范首次发布时间:1978年。

# 中华人民共和国电子行业标准

## 电子元器件详细规范

### 3DA98 型 NPN 硅高频大功率晶体管

SJ/T 11227—2000

代替 SJ 1410—78

**Detail specification for electronic components**

**Type 3DA98 NPN silicon high-frequency power transistor**

---

本规范适用于 3DA98 型硅高频大功率晶体管，它是按照 GB/T 7576—1998《半导体器件 分立器件 第 7 部分 双极型晶体管 第四篇 高频放大管壳额定双极型晶体管空白详细规范》标准对原部标的 SJ 1410—78《3DA98 型 NPN 硅高频大功率三极管》进行修订的，符合 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》和 GB/T 12560—1999《半导体器件 分立器件分规范》的 II 类要求。

本规范引用的标准有 GB/T 4587—1994《半导体分立器件和集成电路 第 7 部分 双极型晶体管》、GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》、GB/T 4937—1995《半导体器件机械和气候试验方法》、GB/T 7581—1987《半导体分立器件外形尺寸》和 GJB 128A—97《半导体分立器件试验方法》。